

μPA68H

Nチャンネル接合形 シリコン複合電界効果トランジスタ 差動増幅用

N-Channel Silicon Dual Junction Field-Effect Transistor
Differential Amplifier

特長/FEATURES

- ステレオ・メイン・アンプ初段の差動増幅用として最適です。
Suitable for the top stage of a stereo main amplifier.
- 電氣的・熱的平衡が優れています。

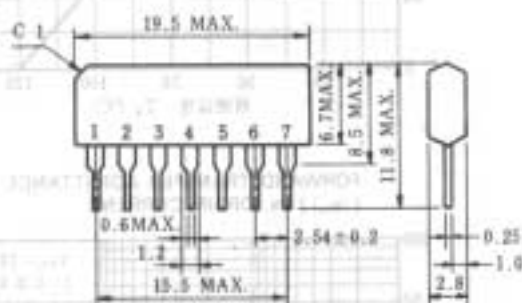
High breakdown voltage.

絶対最大定格/ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T_a=25 °C)

項目	略号	定 格	単 位
ゲート・ドレイン間電圧	V _{GD0}	-50	V
ゲート・ソース間電圧	V _{GS0}	-50	V
ドレイン・ソース間電圧	V _{DS*}	50	V
ドレイン電流	I _D	30	mA
ゲート電流	I _G	10	mA
全 損 失	P _T	250	mW/unit
ジャンクション温度	T _j	125	°C
保 存 温 度	T _{stg}	-55 ~ +125	°C

*V_{GS} = -3.0 V

外形図/PACKAGE DIMENSIONS (Unit: mm)



端子接続/PIN CONNECTION

端子No	機 能	端子No	機 能
1	1D	5	2S
2	1G	6	2G
3	1S	7	2D
4	Sub		

電氣的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_a=25 °C)

項 目	略号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
ゲートシャ断電流	I _{GSS}	V _{GS} = -20 V, V _{DS} = 0			-1.0	nA
ドレイン電流	I _{DSS}	V _{DS} = 10 V, V _{GS} = 0	1.0		18	mA
ドレイン電流比	I _{DSS} 比	V _{DS} = 10 V, V _{GS} = 0, I _{DSS} 比 = I _{DSS} 小/I _{DSS} 大	0.9		1.0	
カットオフ電圧	V _{GS(off)}	V _{DS} = 10 V, I _D = 10 μA	-0.15		-2.5	V
ゲート・ソース間電圧差	ΔV _{GS}	V _{DS} = 10 V, I _D = 1.0 mA		3.0	20	mV
順伝達アドミタンス	y _{fs}	V _{DS} = 10 V, I _D = 1.0 mA, f = 1 kHz	5.0	7.0		mS
順伝達アドミタンス比	y _{fs} 比	V _{DS} = 10 V, I _D = 1.0 mA, f = 1 kHz, y _{fs} 比 = y _{fs} 小 / y _{fs} 大	0.95		1.0	
入 力 容 量	C _{iss}	V _{DS} = 10 V, V _{GS} = 0, f = 1.0 MHz		15		pF
帰 還 容 量	C _{oss}	V _{DS} = 10 V, V _{GS} = 0, f = 1.0 MHz		3.0		pF
雑 音 電 圧	NV	測定回路図参照/See test circuit		25	35	mV

I_{DSS}区分/I_{DSS} Classification K: 1.0~6.0 mA L: 5.0~10 mA M: 9.0~14 mA N: 13~18 mA